
2SC1162

シリコン NPN エピタキシャル形

HITACHI

特長

- 低周波電力増幅用
- 2SA715 とコンプリメンタリペア

外観図

TO-18 MOD



1. Emitter
2. Collector
3. Base

絶対最大定格

(Ta = 25°C)

項目	記号	2SC1162	単位
コレクタ・ベース電圧	V_{CBO}	35	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CEO}	35	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EBO}	5	V
コレクタ電流	I_C	2.5	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(peak)}$	3	A
許容コレクタ損失	P_C	0.75	W
	P_C^{*1}	10	W
接合部温度	T_j	150	°C
保存温度	T_{stg}	-55~+150	°C

【注】 1. $T_C = 25^\circ\text{C}$ における許容値

電気的特性

(Ta = 25°C)

項目	記号	Min	Typ	Max	単位	測定条件
コレクタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)CBO}$	35	—	—	V	$I_C = 1\text{mA}$, $I_E = 0$
コレクタ・エミッタ破壊電圧	$V_{(BR)CEO}$	35	—	—	V	$I_C = 10\text{mA}$, $R_{BE} = \infty$
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	5	—	—	V	$I_E = 1\text{mA}$, $I_C = 0$
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	—	—	20	μA	$V_{CB} = 35\text{V}$, $I_E = 0$
直流電流増幅率	h_{FE}^{*1}	60	—	320		$V_{CE} = 2\text{V}$, $I_C = 0.5\text{A}$
直流電流増幅率	h_{FE}	20	—	—		$V_{CE} = 2\text{V}$, $I_C = 1.5\text{A}$ (Pulse Test)
ベース・エミッタ電圧	V_{BE}	—	0.93	1.5	V	$V_{CE} = 2\text{V}$, $I_C = 1.5\text{A}$ (Pulse Test)
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	—	0.5	1.0	V	$I_C = 2\text{A}$, $I_B = 0.2\text{A}$ (Pulse Test)
利得帯域幅積	f_T	—	180	—	MHz	$V_{CE} = 2\text{V}$, $I_C = 0.2\text{A}$

【注】 1. 2SC1162 は h_{FE} の値により下記のように 3 区分し、現品に表示してあります。

B	C	D
60~120	100~200	160~320

2. I_M は 2 次破壊時における電流によって規定される。



